DERWENT-ACC-NO:

1988-275411

DERWENT-WEEK:

198839

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Epoxy! resin moulding compound- contg. inorganic filler

coated with silicon cpd.

PATENT-ASSIGNEE: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD [MATW]

PRIORITY-DATA: 1987JP-0034724 (February 18, 1987)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO JP 63202621 A PUB-DATE August 22, 1988 LANGUAGE

PAGES 002

MAINTPC N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 63202621A

N/A

1987JP0034724

February 18, 1987

INT-CL (IPC): C08G059/18, C08K009/06, C08L063/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 63202621A

BASIC-ABSTRACT:

Cpd. contains inorganic filler coated with silicon cpd.

The coat of the filler, pref. comprises multiple layer formed from different kinds of silicon cpd.

USE/ADVANTAGE - The cpd. is useful for sealing semiconductor, integrated circuit, filter, rectifier, etc. Unlike conventional epoxy moulding cpd. contg. alumina as filler, which is effective for improving mouldability and thermal conductivity of moulding cpd., the cpd. has excellent mould releasing property and sealing property, beside sufficient mouldability and thermal conductivity.

In an example, a moulding cpd. for sealing semiconductor was obtd. by compounding, pts.wt. epoxy resin 25, phenol resin 10, carbon black 0.5, imidazole hardening agent 0.5, spherical alumina 32, crystaline silica 31.3, aminp-modified silicon cpd. 0.1 and epoxymodified silicon cpd. 0.5, where, each of alumina and silica filler was coated by aminemodified silicon, which is baked at 160 deg.C for 10 min., firstly and then overcoated by epoxy-modified silicon cpd., which is baked at 180 deg.C 30 min., before use. Cpd. thus prepd. showed excellent moulding property and high thermal conductivity.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: POLYEPOXIDE RESIN MOULD COMPOUND CONTAIN INORGANIC FILL COATIN

SILICON COMPOUND

DERWENT-CLASS: A21 A85 L03

CPI-CODES: A05-A01B; A08-M01D; A08-R01; L04-C20A;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1544U; 1694U ; 5085U

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0034 0035 0205 0218 0069 0231 1277 1282 2020 2217 2218 2299 2302 2307 2545 2560 3252 3253 2665 2738 3279 2743

Multipunch Codes: 014 04 040 06- 140 15- 20- 226 229 231 273 299 303 307 308

(9日本国特許庁(JP)

の特許出願公開

母公開特許公報(A)

昭63-202621

filmt_Cl.4

08 L

證別配号

广内整理番号

6公開 昭和63年(1988) 8月22日

C 08 G 59/18 08 K 9/06

63/00

NLD CAH 6609~4J 6845~4J

審査論求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

49発明の名称

エポキシ樹脂成形材料

顧 昭62-34724 创特

願 昭62(1987)2月18日 る田

者 部 の発 明 者 島 井

秀 樹 宗 朝

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

松下電工株式会社 の出頭

大阪府門真市大字門真1048番地

弁理士 竹元 敏丸 四代 理

外2名

1 発明の名称

エポキシ離別成形材料

2 特許請求の範囲

(1) シリコン化合物被磁無機充填剤を含有して なるととを特徴とするエポキタ樹脂成形材料。

シリコン化合物被援が、異独のシリコン化 合物による複数被覆であることを特徴とする特許 請求の鑑囲第1項記載のエポキン樹脂成形材料。

3. 発明の評額な散明

(技術分野)

本発明は半導体を對止するエポキシ樹脂成形材 料に関するものである。

(背景技術)

近年、電気、電子機器の部品の低コスト化と生 厳性肉上のため、プラスチックによる対止がなさ れるようになってきた。これらの電気部品や電子 部品には例えばトランジスター、ダイオード、コ ンデンサー、フイルター、整流器、抵抗体、コイ ル、IC、L8C、8L8I等があり、最近の半 導体デバイスの動向を見るとパッケージの小型化、 デバイスの斉出力が娶釦され、成形性がよく且つ 高熱伝導性の成形材料が盛まれている。との為ア ルミナを含有させるととが検討され、高熱伝導性 は諦成されたが離司性、充壌性等の成形性が大巾 化低下するという問題があった。

(発明の目的)

本発明の目的とするところは、成形性、高熱伝 選性に優れたエポキン問題成形材料を過失するこ とにある。

(発明の関示)

本発明はシリコン化合物被覆無機充填剤を含有 じてなることを特徴とするエポキシ樹脂成形材料 のため、成形性、高熱伝導性を併せ有するエポキ ン樹脂収形材料とするととができたもので、以下 木発明を詳細に説明する。

本発明に用いるシリコン化合物としては、好さ しくはアミノ基かエポキン基のどちらか一方を官 能盐として有するシランモノマー又はオルガノポ リシロキサンを用いるととが蔑ましい。又、シリ

特際昭63-202621(2)

コン化合物被覆が、異種のシリコン化合物による 複数被覆であることが好ましく、被覆に際しては 焼付被覆であることが選ましいことである。無機 光填剤としては好ましくは結晶シリカ、球状アル ミナ等のような高熱伝導性無機充填剤を用いるこ とが気ましい。

第 1 表

		重量等	
	突旋例 1	突施例2	比较例
トモサッ御記	25	25	25
フェノール樹脂	10	10	10
カーボンプラッタ	0.5	0.5	0.5
イミダゾール系領化剤	0.5	0.5	0.5
球状アルミナ	32	63.3	82
結晶シリカ	31.3	6	31
アミノ変性シリコン化合物	0.1	0.1	0
エポキシ変性シリコン化合物	0.1	0.1	0
カップリング剤	0.5	0.5	0.5
カルナパワッタス	0	0	0.5

(森明の効果)

実施例1及び2と比較例の成形性、熱伝導性は 第2表で明白なように本発明のものの性能はよく、 本発明のエポキン樹脂成形材料の優れていること を確認した。 液器、抵抗体、コイル、IC、LSI、VLSI 等の電子部品の多数個取り成形に適することは勿 論、圧縮成形にも適用できるものである。以下本 発明を実施例にもとずいて詳細に説明する。

実施例1万至3と比較例1及び2

第1 表の配合表に従って材料を配合、混合、混 他して半導体対止用エポキシ相脂成形材料を得、 トランスファー成形機を用いて金型温度 175 ℃、 成形圧力の 4/dd、硬化時間 3 分の条件でトランジ スタを対止成形して電子部品を得た。との際、実 施例 1 乃至 3 の球状アルミナ及び結晶シリカにつ いてはアミノ変性シリコン化合物で被覆し 160 ℃ での分加熱後、更にその上にエポキシ変性シリコ ン化合物を被覆し 180 ℃での分加熱してから用い た。

第 2 表

			突旋例 1	突施例 2	比較例
成	形	性	0	0	××
嬔	伝 事	性	0	0	0

特 許 出 顧 人 松 下 覧 工 株 式 会 社 代理人介理士 竹 元 敏 九 (紀か2名)